

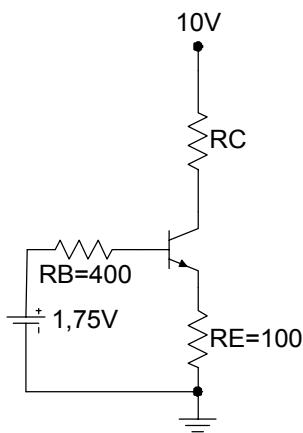
Problema 16

En el circuito de la figura $ICQ=10\text{mA}$ a temperatura ambiente ($T_a=25^\circ\text{C}$).

Utilizando los factores de estabilidad calcular la variación de ICQ si la temperatura aumenta hasta 55°C para:

- Transistor de silicio ($ICB0=1\mu\text{A}$ a $T_a=25^\circ\text{C}$)
- Transistor de germanio ($ICB0=100\mu\text{A}$ a $T_a=25^\circ\text{C}$)

Considerando que el circuito tiene buena estabilidad frente a las variaciones de hFE , calcular el ΔICQ debido a las variaciones de $ICB0$ y VBE .



Calcular ΔICQ

$$\left. \begin{array}{l} \Delta VBE \\ \Delta ICB0 \end{array} \right\}$$

Verifico la condición de apantallamiento:

$$n = \frac{\frac{RE}{RB}}{\frac{\beta_{min}}{40}} = \frac{\frac{100}{400}}{\frac{40}{40}} = 10 \quad \text{OK}$$

Calculo $IC = f(VBE; ICB0)$

Para variaciones pequeñas:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_I = \frac{\Delta ICQ}{\Delta ICB0} \cong \frac{\partial ICQ}{\partial ICB0} \\ S_V = \frac{\Delta ICQ}{\Delta VBE} \cong \frac{\partial ICQ}{\partial VBE} \end{array} \right.$$

$$S_I = \frac{RE + RB}{RE + \frac{RB}{1+\beta}} = \frac{400 + 100}{100 + \frac{400}{81}} = 4,765$$

$$S_V = \frac{1}{\frac{RB}{\beta} + RE \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)} = -\frac{1}{\frac{400}{80} + 100 \cdot \left(1 + \frac{1}{80}\right)} = -9,412 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega}$$

ahora planteo las diferencias:

$$VBE_2 - VBE_1 = -2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot (T_2 - T_1) = -7,5mV$$

Entonces para silicio tenemos:

$$\Delta ICB0 = ICB0_2 - ICB0_1 = ICB0_1 \cdot \left[2^{\frac{T_2-T_1}{10}} - 1 \right] = 7 \mu A$$

$$\Delta ICQ \cong S_I \cdot \Delta ICB0 + S_V \cdot \Delta VBE = 4,76 \cdot 7 \mu A + 9,41 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega} \cdot 0,075V = 0,74mA$$

donde influye ΔVBE .

Para germanio sería ahora:

$$ICB0_2 - ICB0_1 = 700 \mu A$$

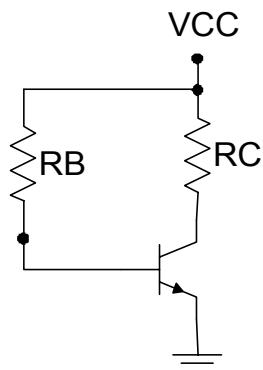
$$\Delta ICQ = 4,76 \cdot 700 \mu A + 9,41 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\Omega} \cdot 0,075V = 4,04mA$$

donde influye $\Delta ICB0$

Problema 17

Para el siguiente circuito (polarización IB constante), encontrar las expresiones de los factores de estabilidad para un punto de trabajo genérico en la zona activa del transistor.

(Sv, ShFE, SI)



$$SI = \beta + 1 \approx \beta$$

$$Sv = -\frac{\beta}{RB}$$

$$S\beta = \frac{VCC - VB}{RB} - ICB0$$

$$(I) \quad IC = \beta \cdot IB + (\beta + 1) \cdot ICB0$$

$$(II) \quad VCC - IB \cdot RB - VBE = 0$$

de (I):

$$IB = \frac{IC - (\beta + 1) \cdot ICB0}{\beta} \quad (a)$$

de (II):

$$IB = \frac{VCC - VBE}{RB} \quad (b)$$

Igualando (a) y (b):

$$\frac{IC - (\beta + 1) \cdot ICB0}{\beta} = \frac{VCC - VBE}{RB}$$

$$IC = \frac{VCC - VBE}{RB} + (\beta + 1) \cdot ICB0$$

Para hallar $\frac{\partial C}{\partial VBE}$ y $\frac{\partial C}{\partial ICB0}$:

$$\frac{\partial C}{\partial ICB0} = \beta + 1 = S_I$$

$$\frac{\partial C}{\partial VBE} = -\frac{\beta}{RB} = S_V$$

$$\frac{\Delta IC}{\Delta \beta} = \frac{\left(\frac{VCC-VB}{RB}\right) \cdot \beta_2 + ICB0 \cdot (\beta_2 + 1) - \left(\frac{VCC-VBE}{RB}\right) \cdot \beta_1 - ICB0 \cdot (\beta_1 + 1)}{\beta_2 - \beta_1}$$

$$\frac{\Delta IC}{\Delta \beta} = \frac{VCC-VBE}{RB} + ICB0 = S_{hFE}$$

Condición de estabilidad térmica:

El calor generado en la juntura de colector no debe exceder al que pueda disiparse en régimen permanente.

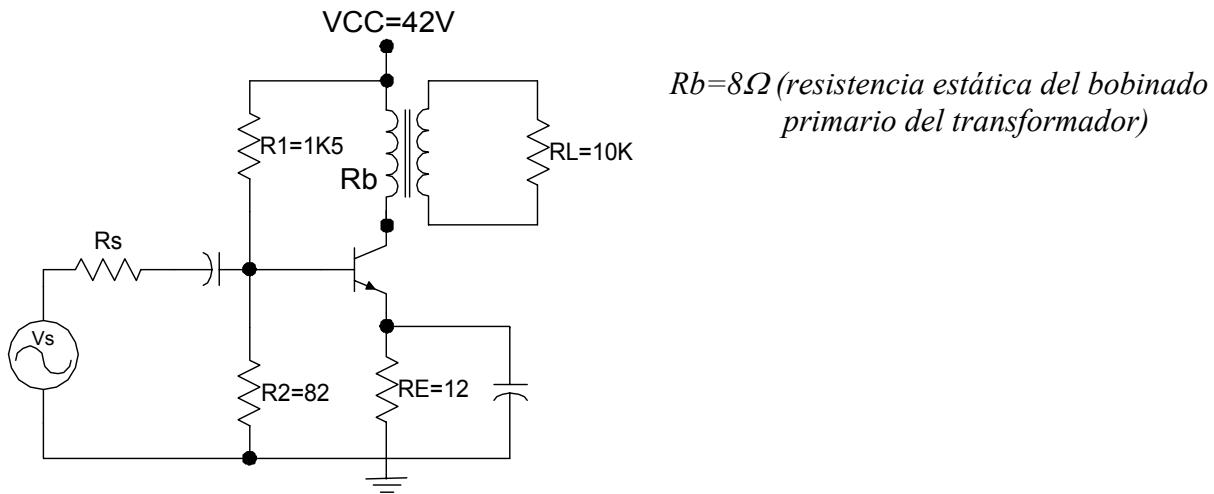
$$\frac{\partial Pdt}{\partial Tj} < \frac{\partial Pc}{\partial Tj}$$

$$\frac{\partial Pdt}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja}$$

$$\frac{\partial Pdt}{\partial C} \cdot \frac{\partial C}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja}$$

Problema 18

Para el circuito de la figura, implementado con el transistor BD137, analizar si puede producirse embalamiento térmico cuando la temperatura aumenta de 25°C a 65°C.



Datos del manual:

$$T_{jmax} = 150^\circ C$$

$$R_{th_{j-a}} = 100 \frac{^\circ C}{W}$$

$$R_{th_{j-mb}} = 10 \frac{^\circ C}{W}$$

$$P_{tmax} = 8W \text{ para } T_{mb}=70^\circ C$$

$$VCE0max = 60V$$

$$ICB0 \leq 100nA \text{ para } T_j=25^\circ C$$

$$RB = R1 \parallel R2 = 77,8\Omega$$

$$VBB = 2,17V$$

$$ICQ = \frac{VBB - 0,7V}{RE + \frac{RB}{hFE}} = \frac{2,17V - 0,7V}{12\Omega + \left(\right)} = 123mA \rightarrow hFE = 95$$

$$ICQ = \frac{2,17V - 0,7V}{12\Omega + \frac{77,8\Omega}{95}} = 114mA \rightarrow hFE = 97$$

$$ICQ = \frac{2,17V - 0,7V}{12\Omega + \frac{77,8\Omega}{97}} = 115mA$$

$$VCC = VCEQ + ICQ \cdot (Rb + RE) \Rightarrow VCEQ = VCC - ICQ \cdot (Rb + RE)$$

$$VCEQ = 42V - 115mA \cdot (20\Omega) = 39,7V$$

1^a CONDICION

$$VCEQ < \frac{VCC}{2} \quad \text{no se cumple !!}$$

CONDICION GENERAL

$$\frac{\partial Pdt}{\partial IC} \cdot \frac{\partial IC}{\partial Tj} < \frac{1}{\theta ja}$$

$$(VCC - 2 \cdot ICQ \cdot Rb) \cdot \left(S_I \cdot \frac{\Delta ICB0}{\Delta T} + S_V \cdot \frac{\Delta VBE}{\Delta T} + S_{hFE} \cdot \frac{\Delta hFE}{\Delta T} \right) < \frac{1}{\theta ja}$$

$$S_I = \frac{\partial ICQ}{\partial ICB0} = \frac{RE + RB}{RE + \frac{RB}{1 + \beta}} = 7,02$$

$$S_V = -\frac{1}{\frac{RB}{\beta} + RE \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)} = -77,3 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{\Omega}$$

$$\Delta VBE = -2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot (T_2 - T_1) \Rightarrow \frac{\Delta VBE}{\Delta T} = -2,5 \frac{mV}{^{\circ}C}$$

$$\Delta ICB0 = ICB0_1 \cdot \left(2^{\frac{T2-T1}{10}} - 1 \right) = 100nA \cdot \left(2^{\frac{65^{\circ}C - 25^{\circ}C}{10}} - 1 \right) = 1,5 \mu A$$

$$(VCC - 2 \cdot ICQ \cdot \text{Resist}) \cdot \left(S_I \cdot \frac{\Delta ICB0}{\Delta T} + S_V \cdot \frac{\Delta VBE}{\Delta T} \right) < \frac{1}{\theta ja}$$

$$(42V - 2 \cdot 115mA \cdot 20\Omega) \cdot \left[7,02 \cdot \frac{1,5\mu A}{40^\circ C} + \left(-77,3 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1}{\Omega} \right) \cdot \left(-2,5 \frac{mV}{^\circ C} \right) \right] < \frac{1}{100^\circ C/W}$$

$7,24 \frac{mW}{^\circ C} < 10 \frac{mW}{^\circ C}$

se cumple

“No existe embalamiento térmico”.